

## Si-pnp-HF-Transistoren

Высокочастотные кремниевые транзисторы с р-п-р структурой

Typ Тип	Grenzdaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ Предельные значения при					elektr. Kenndaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ Электр. параметры при								
	$P_{tot}$ mW	$-U_{CBO}$ V	$-U_{CEO}$ V	$-U_{EBO}$ V	$-I_C$ mA	$h_{21E}$	bei при $-U_{CE}$ V	$-I_C$ mA	$f_T$ MHz	$-U_{CEsat}$ V	bei при $-I_C$ mA	$-I_B$ mA	$-I_{CBO}$ $\mu\text{A}$	bei при $-U_{CBO}$ V
SF 016	700	75	45	5	600	28... 71	10	10	$\geq 50^7)$	$\leq 0,5$	150	15	$\leq 0,1$	
SF 018	700	75	45	5	600	112...140	10	10	$\geq 60^7)$	$\leq 0,5$	150	15	$\leq 0,1$	60
SF 116	600	33	20	5	500	28...560 <sup>4)</sup>	2	50	60 <sup>8)</sup>	$\leq 0,5$	150	15	$\leq 0,1$	60
SF 117	600	66	30	5	500	28...560 <sup>4)</sup>	2	50	60 <sup>8)</sup>	$\leq 0,5$	150	15	$\leq 0,1$	33
SF 118	600	100	60	5	500	28...560 <sup>4)</sup>	2	50	60 <sup>8)</sup>	$\leq 0,5$	150	15	$\leq 0,1$	66
SF 119	600	120	80	5	500	28...560 <sup>4)</sup>	2	50	60 <sup>8)</sup>	$\leq 0,5$	150	15	$\leq 0,1$	100

1)  $U_{CE} = 10\text{ V}$ ,  $I_C = 1\text{ mA}$ ,  $f = 100\text{ MHz}$

2)  $U_{CE} = 10\text{ V}$ ,  $I_C = 4\text{ mA}$ ,  $f = 100\text{ MHz}$

3)  $U_{CE} = 10\text{ V}$ ,  $I_C = 7\text{ mA}$ ,  $f = 100\text{ MHz}$

4)  $U_{CE} = 10\text{ V}$ ,  $I_C = 10\text{ mA}$ ,  $f = 100\text{ MHz}$

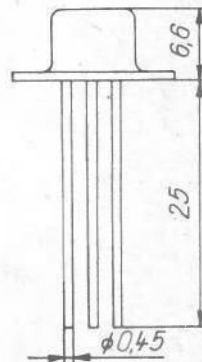
5)  $U_{CE} = 10\text{ V}$ ,  $I_C = 10\text{ mA}$ ,  $f = 15\text{ MHz}$

6) selektiert nach Stromverstärkungsgruppen  
 $h_{21E}$  bei/при  $f = 1\text{ kHz}$

выбираются по разрядам усиления тока

7)  $-U_{CE} = 10\text{ V}$ ,  $-I_C = 50\text{ mA}$ ,  $f = 15\text{ MHz}$

8)  $-U_{CE} = 10\text{ V}$ ,  $-I_C = 10\text{ mA}$ ,  $f = 15\text{ MHz}$



SF 126...SF 129  
SF 016, SF 018  
SF 116...SF 119